

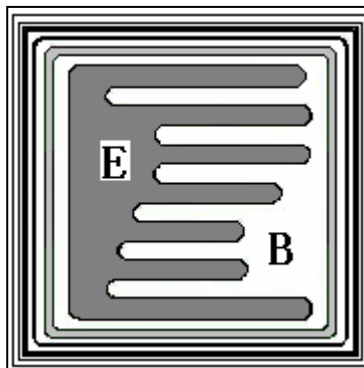


13002 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D142AG-00
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：1420 × 1420μm²
 焊位尺寸：B 极 300×245μm²，E 极 350×245μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银或金
 典型封装：KSE13002，HE13002

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-126)

T _{stg} ——贮存温度.....	-65~150
T _j ——结温.....	150
P _C ——集电极功率耗散 (T _c =25)	30W
V _{CBO} ——集电极—基极电压.....	600V
V _{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V _{EBO} ——发射极—基极电压.....	9V
I _C ——集电极电流 (DC)	1.5A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-126)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	600			V	I _C =1mA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	I _E =1mA, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =10V, I _C =0.1A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1.8	V	I _C =1A, I _B =200mA
				0.8	V	I _C =0.5A, I _B =100mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =0.5A, I _B =100mA
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	V _{CB} =500V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	V _{EB} =9V, I _C =0
f _T	特征频率	8			MHz	V _{CE} =10V, I _C =0.1A, f=1MHz
t _{ON}	导通时间			1.1	μs	V _{CC} =125V, I _C =1A I _{B1} =-I _{B2} =0.2A R _L =125Ω
t _{STG}	贮存时间			4.0	μs	
t _F	下降时间			0.7	μs	